

概述

J O 8327 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换：全亮（100%）--暗亮（25%）--爆闪。

J O 8327 内置 100V /3A 功率 MOS，采用固定关断时间的控制方式，关断时间可通过外部电容进行调节，因此工作频率可根据用户要求而设置。

J O 8327 通过一个外接电阻来设置 LED 的输出电流。

J O 8327 内部还集成了 VDD 稳压管，过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。

J O 8327 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。

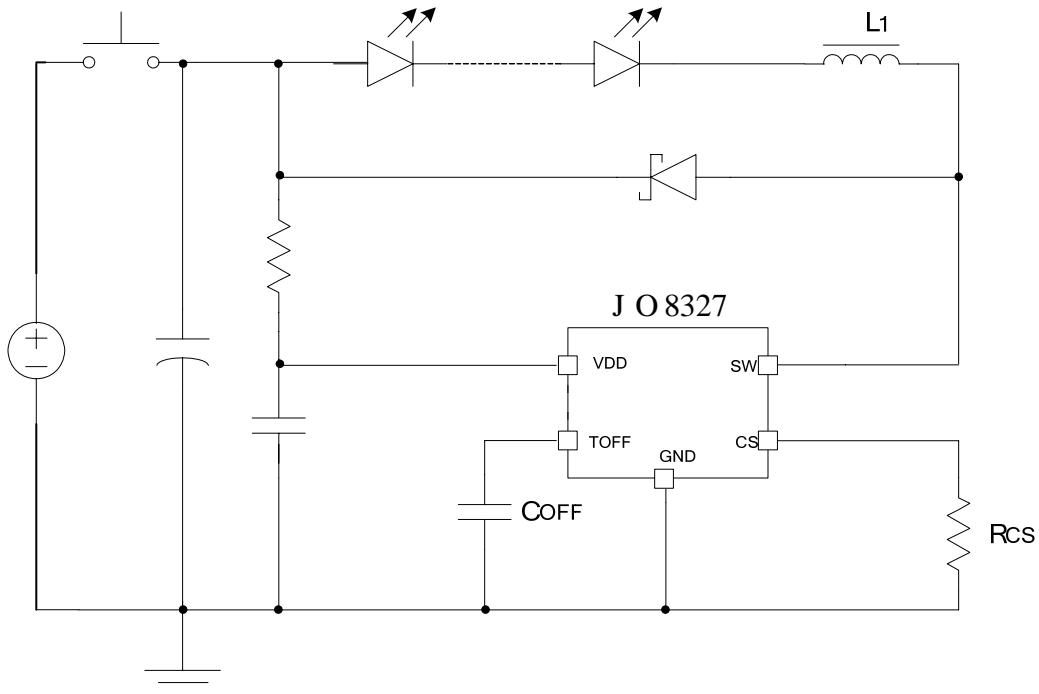
特点

- ◆ 内置 100V /3A 功率 MOS
- ◆ 内置三功能：100%-25%-爆闪
- ◆ 宽输入电压范围：3.6V~100V
- ◆ 高效率：可高达 90%
- ◆ 芯片供电欠压保护：3.2V(迟滞 0.5V)
- ◆ 峰值电流采样电压：250mV
- ◆ 关断时间可调
- ◆ 内置过温调节
- ◆ 内置 VDD 稳压管

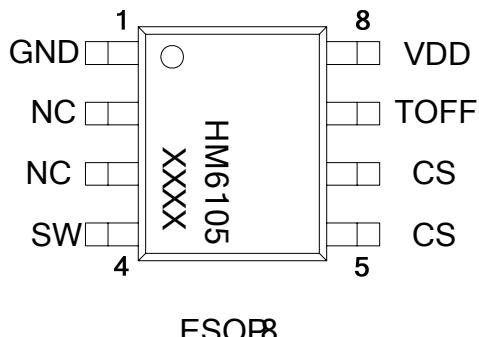
应用

- ◆ LED 手电筒
- ◆ 自行车灯、电动车灯
- ◆ 大功率 LED 照明

典型应用电路图



封装及管脚分配



管脚定义

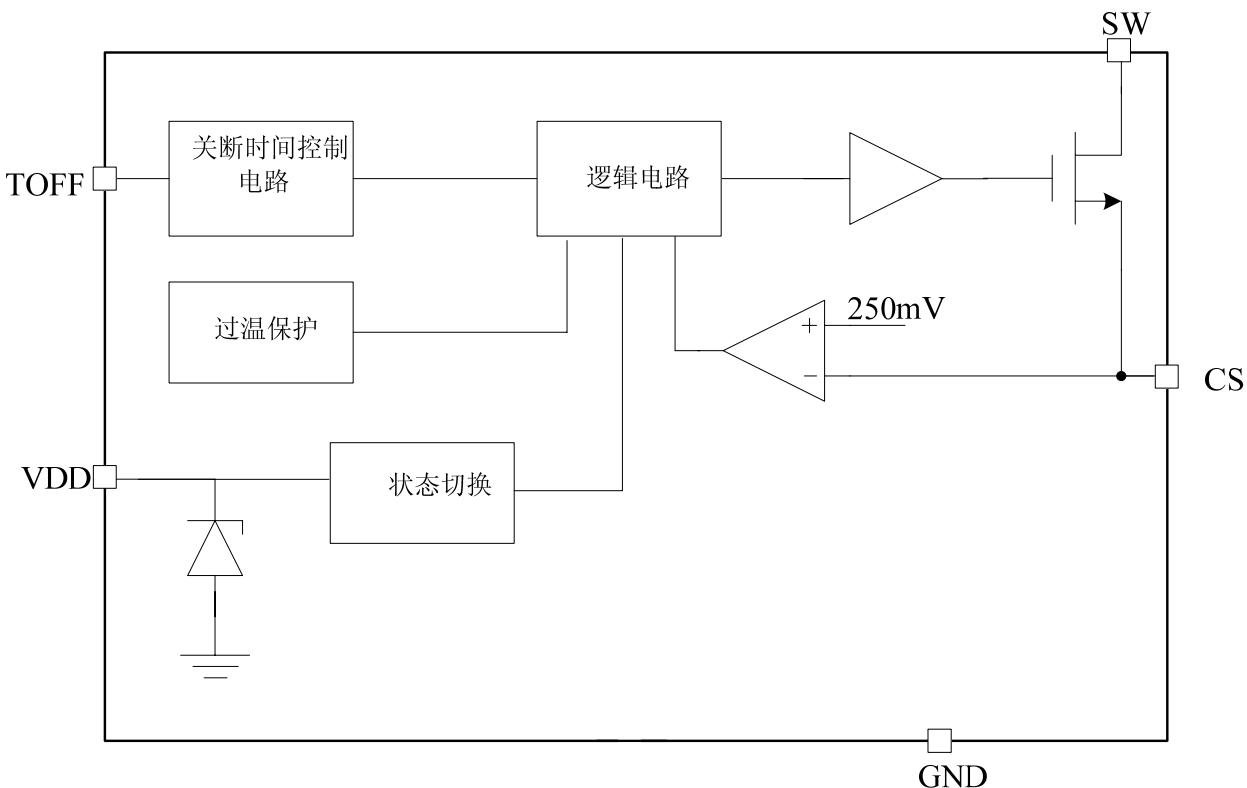
管脚号	管脚名	描述
1	GND	接地
2	NC	悬空不接
3	NC	悬空不接
4	SW	开关脚，接内置 MOS 管漏极。
5、6	CS	电感峰值电流检测脚
7	TOFF	关断时间设置
8	VDD	芯片电源

极限参数^(注1)

符 号	描述	参数范围	单位
VDD	VDD 端最大电压	6	V
V _{MAX}	CS、TOFF 管脚电压	-0.3~VDD+0.3	V
P _{ESOP8}	ESOP8 封装最大功耗	0.8	W
V _{SW}	SW 脚最大电压	100	V
T _A	工作温度范围	-20~85	°C
T _{SD}	焊接温度范围(时间小于 30 秒)	240	°C
V _{ESD}	静电耐压值 (人体模型)	2000	V

注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

内部电路方框图



电特性

除非特别说明, $V_{DD}=5.5V$, $T_A=25^{\circ}C$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
VDD 钳位电压	V_{DD}	$IVDD < 10mA$		5.5		V
欠压保护电压	V_{DD_UVLO}	V_{DD} 上升		3.2		V
欠压保护迟滞	V_{DD_HYS}			0.5		V
电源电流						
工作电流	I_{OP}	$F_{OP}=200KHz$		1.3		mA
待机输入电流	I_{INQ}	无负载, EN 为低电平		200		uA
峰值电流采样						
VCS 阈值	V_{CS_TH}		245	255	265	mV
关断时间						
最小关断时间	T_{OFF_MIN}	TOFF 脚无外接电容		650		ns
爆闪频率						
爆闪频率	F_{FLASH}			8		Hz
内置 MOS 开关管						
MOS 管耐压	V_{DS}		100			V
MOS 管导通内阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=5V$		200		$m\Omega$
过温保护						
过温调节	OTP_TH			140		$^{\circ}C$

应用指南

工作原理

J O 8327 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换：全亮（100%）--暗亮（25%）--爆闪（8Hz）。

J O 8327 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。电路工作在开关管导通和关断两种状态。

参见首页所示的典型应用电路图，当MOS开关管处于导通状态时，输入电压V_{IN}通过LED灯、电感L₁、MOS开关管、电流检测电阻R_{CS}对电感充电，流过电感的电流随充电时间逐渐增大，当电流检测电阻R_{CS}上的电压降达到电流检测阈值电压V_{CS_TH}时，控制电路关断MOS开关管。

当MOS开关管处于关断状态时，电感通过由LED灯、续流二极管以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS开关管在关断一个固定的时间T_{OFF}后，重新回到导通状态，并重复以上导通与关断过程。

T_{OFF}设置

固定关断时间可由连接到TOFF引脚端的电容C_{OFF}设定：

$$T_{OFF} = 0.51 * 150K\Omega * (C_{OFF} + 8pF) + T_D$$

其中T_D=61ns。

如果不外接C_{OFF}，内部将关断时间为 650ns。

输出电流设置

LED输出电流由电流采样R_{CS}以及T_{OFF}等参数设定：

$$I_{LED} = \frac{0.25}{R_{CS}} - \frac{V_{LED} * T_{OFF}}{2L_1}$$

其中V_{LED}是LED的正向导通压降，L₁是电感值。

电感取值

为保证系统的输出恒流特性，电感电流应工作在连续模式，要求的最小电感取值为：

$$L_1 > 4V_{LED} * T_{OFF} * R_{CS}$$

系统工作频率

系统工作频率F_S由下式确定：

$$F_S = \frac{V_{IN} - V_{LED}}{V_{IN} * T_{OFF}}$$

芯片布局考虑

电流检测电阻RCS到芯片CS引脚以及GND引脚的连线需尽量粗而短，以减小连线寄生电阻对输出电流精度的影响。

供电电阻选择

J O 8327 通过供电电阻 R_{VDD} 对芯片VDD供电。

$$R_{VDD} = \frac{V_{IN} - VDD}{I_{VDD}}$$

其中VDD取 5.5V, I_{VDD} 典型值取 2mA, VIN为输入电压。当开关频率设置的较高或者MOS管的输入电容较大时，芯片工作电流会增大，相应地应减小供电电阻取值。

芯片内部接VDD脚的稳压管最大钳位电流不超过 10mA，应注意 R_{VDD} 的取值不能过小，以免流入VDD的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

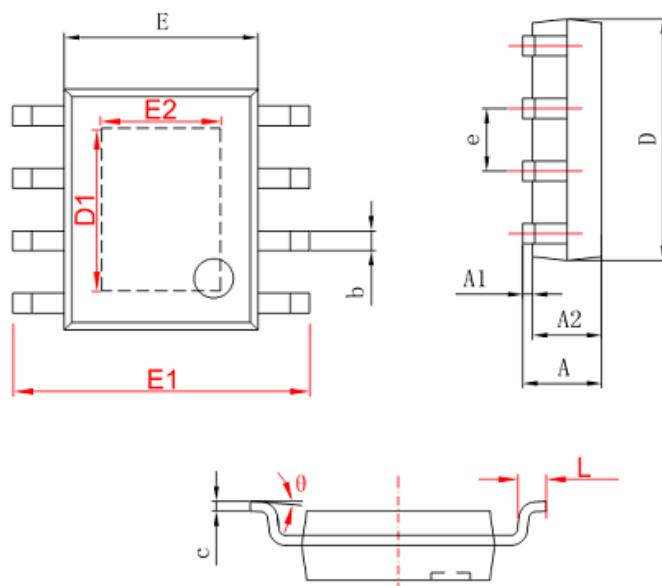
过温保护

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用：随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

封装信息

ESOP8 封装参数:

- SOP-8/PP



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°